

关键指标

频率：8~12GHz
均衡量：1dB, 2dB, 3dB
插入损耗：0.6dB
芯片尺寸：0.8mm×0.8mm

产品简介

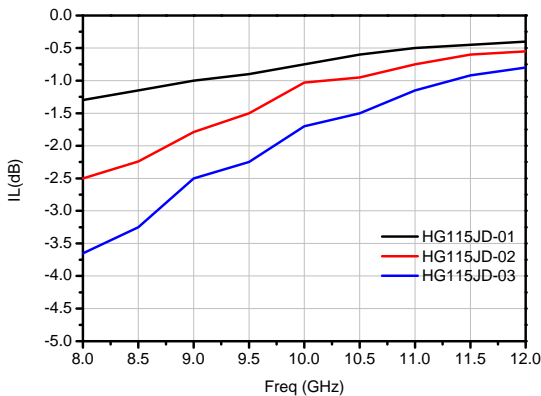
HG115JD 是一系列 8~12GHz 均衡器芯片，均衡量为 1dB/2dB/3dB，输入输出驻波分别为 1.2/1.2。

电性能 (T_A=25℃)

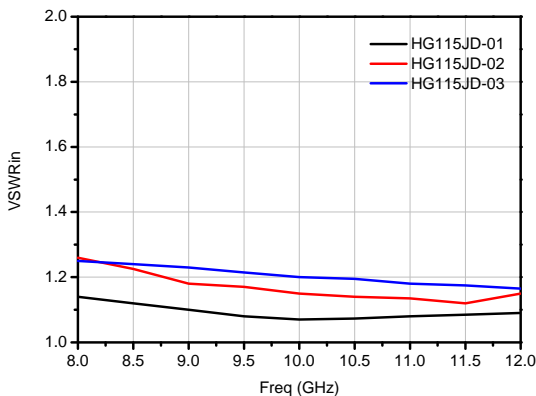
型号	频率 (GHz)	均衡量 (dB)	插入损耗 (dB)	驻波
HG115JD-01	8~12	1	0.6	1.3
HG115JD-02		2	0.6	1.2
HG115JD-03		3	0.6	1.2

典型测试曲线

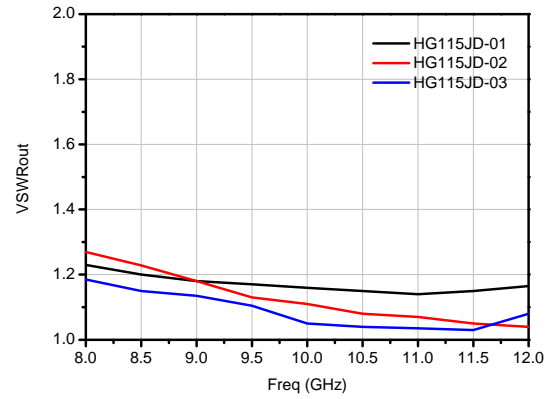
插入损耗



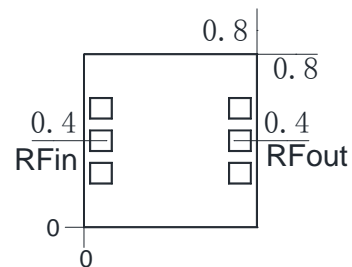
输入驻波



输出驻波



外形和端口尺寸 (mm)



绝对额定最大值

最大输入功率	+27dBm
工作温度	-55℃~125℃
存储温度	-65℃~150℃

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 Φ25μm 双金丝键合，建议金丝长度 250~400μm；
5. 芯片微波端无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。